

奈米級金屬氧化物薄膜共濺鍍熱處理系統



設備負責人：陳信助助理教授 TEL：07-5252000#6612

Mail：chenhc@mail.nsysu.edu.tw

謝佳旭助理教授 TEL：07-5252000#6618

Mail：ch.hsieh@mail.nsysu.edu.tw

王俊明教授 TEL：07-5252000#6616

Mail：albert.wang@g-mail.nsysu.edu.tw

設備管理人：賴永裕先生 TEL：07-5252000#6635

Mail：laiyy@mail.nsysu.edu.tw

儀器資訊：

1. 廠牌型號：高敦科技
2. 購置年限：114 年 4 月
3. 放置地點：電資大樓地下室 EC0002(真空鍍膜無塵室)
4. 功能：氧化物薄膜濺鍍、高溫熱退火
5. 規格：

I. 晶圓電漿清潔系統：

- i. 可放置 6 吋、4 吋或破片載盤。
- ii. RF power 300 W 一台

II. 濺鍍系統：

- i. 可放置 6 吋、4 吋或破片載盤。
- ii. RF power 600 W 一台
- iii. HiPIMS 1000 W 一台

III. 快速熱退火系統(RTA)：

- i. 可放置 6 吋晶圓以下試片。
- ii. 最高溫度 1000°C(恆溫 60 秒)。

6. 可放置材料：氧化鋅、氧化銅、銅、鋅。其餘未公告之材料，請向管理人員提出申請且經設備負責人同意後才可使用。
7. 使用快速熱退火系統時，試片不可含光阻。

自行操作：

經具有設備自行操作資格人員訓練後且通過考核方取得自行操作資格。

(詳請參閱：本網頁規章表單>設備操作辦法>自行操作資格取得辦法)

委託操作：

請至「晶片驅動-全台半導體資源共享平台」預約，再於本網頁下載委託操作申請表，將申請表填寫好後送至半導體聯合實驗室由管理人員進行委託代工服務。

收費資訊：

收費標準(單位：元/時)	自行操作	委託操作
學術單位	1000	1500
業界單位	2000	